

a 2005 0231

Invenția se referă la tehnologia semiconductorilor, în particular la procedee de obținere a nanostructurilor semiconductoare.

Procedeul de obținere a nanostructurilor semiconductoare constă în decaparea electrochimică a suprafețelor semiconductoare. Noutatea invenției constă în aceea că decaparea electrochimică se efectuează cu aplicarea impulsurilor de tensiune într-o soluție cu următorul raport al componentelor:

H ₃ PO ₄	10 ml
HNO ₃	10 ml
Na ₂ Cr ₂ O ₇	0...10 g
H ₂ O	300 ml.

Revendicări: 1

Figuri: 2